

報道関係各位

2026年1月28日  
セイコーエプソン株式会社

### 大学・企業と共に創し、次世代エッジAI半導体の国家プロジェクトへ参画

セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）は、国立研究開発法人 科学技術振興機構（以下 JST）が公募し、採択された「次世代エッジAI半導体研究開発事業」に参画することになりましたので、お知らせいたします。

近年、データ処理需要の急増に伴い、クラウドに依存せず、端末単体で高性能なAI処理を実現するエッジAI半導体が注目されています。フィジカルAIの利用が進むことで、より高い処理能力を備えたAI半導体の開発が求められています。本事業は、産学が一体となり、高性能・高機能な次世代エッジAI半導体の開発を目指す国家プロジェクトです。

この中で、エプソンは、東北大学などと次世代エッジAI半導体に不可欠な技術要素のひとつである「3Dヘテロ集積技術」の研究開発に取り組みます。この技術は、異なる種類の材料を組み合わせ、複数のチップや光部品を小さなスペースに高密度で立体的に集積するものです。高性能・高機能な半導体の実現には、こうした高密度実装技術が欠かせません。

エプソンは、長年培ってきた低消費電力の半導体技術と高密度実装のノウハウを活かし、これらを融合させることで、次世代エッジAI半導体の開発に貢献してまいります。

#### 【事業概要】

- **研究開発課題名**：エッジAI半導体を実現する3Dヘテロ集積技術
- **研究者代表者**：東北大学 大学院医工学研究科 教授 田中 徹
- **研究分担機関**：東北大学、北海道大学、東京大学、熊本大学、セイコーエプソン株式会社、ほか民間企業6社
- **事業期間**：2025年度から5年間
- **詳細**

JSTホームページ <https://www.jst.go.jp/program/edge-ai-semicon/>

東北大学プレスリリース <https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2025/12/press20251218-01-ai.html>

※エプソンは、「エッジAI半導体を実現する3Dヘテロ集積技術」プロジェクトグループの中で、「異種材料低温ハイブリッド接合・インターポーラ技術開発グループ」に属します。

以上